# Отчет о выполнении лабораторной работы 3.5.1 "Изучение плазмы газового разряда в неоне"

Алпатова Александра, Калашников Михаил, Б03-205

**Цель работы:** Изученние ВАХ тлеющего разряда; свойств плазмы методом зондовых характеристик.

#### В работе используются:

- стеклянная газоразрядная трубка, наполненная неоном;
- высоковольтный источник питания;
- источник питания постоянного тока;
- делитель напряжения;
- резистор;
- потенциометр;
- амперметры;
- вольтметры;
- переключатели.

#### Теоретическая справка

Двойным зондом назывется система, состоящая их двух одинаковых зондов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Между зондами создаётся разность потенциалов U, которая по велиине много меньше плавающего потенциала:  $|U| \ll |U_f|$ . При этом оба зонда имеют относительно плазмы близкий к плавающему отрицательный потенциал, т.е. находятся на ионной ветви вольт-амперной характеристики.

При отсутствии разности потенциалов ток между зондами равен нулю. Рассчитаем величину тока, проходящего через двойной зонд вблизи точки I=0. При небольших разностях потенциалов ионные токи на оба зонда равны ионному току насыщения и компенсируют друг друга. Величина результирующего тока целиком связана с различием в электронных токах. Пусть потенциал на первом зонде равен

$$U_1 = U_f + \Delta U_1,$$

а на втором

$$U_2 = U_f + \Delta U_2.$$

Предполагается, что  $\Delta U_1, \Delta U_2 \ll U_f$ . Напряжение U между зондами равно

$$U = U_2 - U_1 = \Delta U_2 - \Delta U_1$$
.

Найдём ток, приходящий на первый электрод:

$$I_1 = I_{i\text{H}} - I_{e0} \exp\left\{\left(\frac{eU_1}{k_{\text{B}T_e}}\right)\right\} = I_{i\text{H}} - \left[I_{e0} \exp\left\{\left(\frac{eU_f}{k_{\text{B}T_e}}\right)\right\}\right] \exp\left\{\left(\frac{e\Delta U_1}{k_{\text{B}T_e}}\right)\right\}.$$

Заметим, что при  $\Delta U_1=0$  (при  $U_1=U_f$ ) электронный и ионный ток компенсируют друг друга. Это означает, что заключённый в квадратные скобки множитель равен  $I_{i\mathrm{H}}$ . Имеем поэтому

$$I_1 = I_{i_{\rm H}} \left[ 1 - \exp \left\{ \left( \frac{e \Delta U_1}{k_{{\rm B}T_e}} \right) \right\} \right].$$

Аналогично для второго электрода

$$I_2 = I_{iH} \left[ 1 - \exp \left\{ \left( \frac{e\Delta U_2}{k_{\mathrm{B}T_e}} \right) \right\} \right].$$

Заметим, что зонды 1 и 2 соединены последовательно — через плазму — поэтому  $I_1=-I_2=I$ . Выразим  $\Delta U_1$  и  $\Delta U_2$  из уравнений выше:

$$\Delta U_1 = \frac{k_{\rm B}T_e}{e}\ln\bigg(1 - \frac{I}{I_{i_{\rm H}}}\bigg), \ \Delta U_2 = \frac{k_{\rm B}T_e}{e}\ln\bigg(1 + \frac{I}{I_{i_{\rm H}}}\bigg).$$

Наконец, вычитая второе равенство из первого, найдём

$$U = \Delta U_1 - \Delta U_2 = \frac{k_{\rm B} T_e}{e} \ln \left( \frac{I_{i\rm H} - I}{I_{i\rm H} + I} \right),$$

и, разрешая это равенство относительно I, получим

$$I = I_{iH} th \frac{eU}{2k_{\rm B}T_e}.$$

Эту формулу можно использовать для определния температуры электронов по форме вольт-амперной характеристики двойного зонда.

Наблюдаемая на опыте зависимость тока от напряжения изображена на рисунке 1. Заметим, что эта кривая отличается от теоретической существованием наклона у асимптот в области больших |U|, что связано с ускорением частиц плазмы приложенным полем, которое не учтено при выводе теоретической зависимости.

Графики типа 1 проще всего обрабатывать следующим образом. Сначала находится ток насыщения  $I_{i\mathrm{H}}$  из пересечения асимптот с осью U=0. Затем находится наклон графика в начале координат, из которого можно определить температуру электронов  $T_e$ . Дифференциируя формулу для I по U в точке U=0 и принимая во внимание, что при малых аргументах th  $x\approx x$ , найдём

$$k_{\rm B}T_e = \frac{1}{2} \frac{eI_{i\rm H}}{\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}|_{U=0}},$$

где  $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}|_{U=0}$  — наклон характеристики зонда вблизи начала координат. По известным  $T_e$  и  $I_{i\mathrm{H}}$  можно найти концентрацию заряженных частиц  $n_i=n_e$ .

Таким образом, двойные зонды удобно применять для измерения электронной температуры и концентрации частиц в плазме.

# Экспериментальная установка

Схема установки для исследования плазмы газового разряда в неоне представлена на рисунке 2. Стеклянная газоразрядная трубка имеет холодный

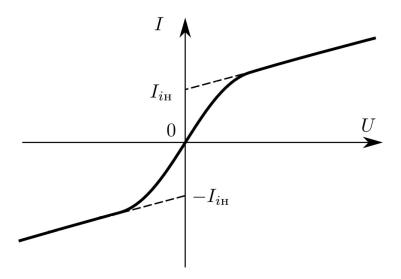


Рис. 1: Вольт-амперная характеристика двойного зонда

(ненагреваемый) полый катод, три анода и геттерный узел — стеклянный балон, на внутреннюю поверхность которого напылена газопоглощающая плёнка (геттер). Трубка наполнена изотопом неона  $^{22}$ Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодов (I или II) с помощью переключателя  $\Pi_1$  подключаются через балластный резистор  $R_6$  ( $\sim 450~\rm k\Omega$ ) к регулируемому высоковольтному источнику питания (ВИП) с выходным напряжением до 5 кВ.

При подключении к ВИП анода-I между ним и катодом возникает газовый разряд. Ток разряда измеряется миллиамперметром  $A_1$ , а падение напряжение на разрядной трубке — цифровым вольтметром  $V_1$  (мультиметром GDM), подключённым к трубке через высоомный (25 М $\Omega$ ) делитель напряжения с коэффициентом  $\frac{R_1+R_2}{R_2}=10$ . При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве меж-

При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве между катодом и анодом-II, где находится двойной зонд, используемый для диагностики плазмы положительного столба.

Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром d=0,2 мм и имеют длину l=5,2 мм. Они подключены к источнику питания GPS через потенциометр R. Переключатель  $\Pi_2$  позволяет изменять полярность напряжения на зондах. Величина напряжения на зондах изменяется с помощью дискретного переключателя "V"выходного напряжения источника питания и потециометра R, а измеряется цифровым вольтметром  $V_2$  (GMD). Для измерения зондового тока используется мультиметр  $A_2$  (GDM). Анод-III в нашей работе не используется.

### 1. Проведение эксперимента

1. Определим напряжение зажигания разряда по нескольким измерениям:  $U_{\mathrm{заж}} = 206 \pm 8 \; \mathrm{B}.$ 

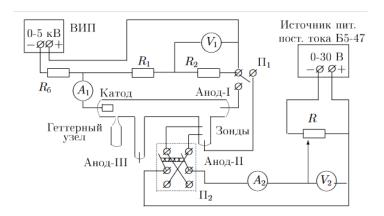


Рис. 2: Схема установки для исследования газового разряда

- 2. Проведем измерение BAX разряда. Полученные точки приведены на рис. 1.
- 3-4. Подготовим оборудование к измерению зондовых характеристик.
  - 5. Проеведем измерения ВАХ двойного зонда в диапазоне от -25 В до 25 В при токе разряда  $I_{\rm p}=5$  мА.
  - 6. Повторим предыдущие пункты для токов разряда 3 мА и 1.5 мА.
  - 7. Выключим все использовнное оборудование и зафиксируем параметры зондов: d=0.2 мм, l=5.2 мм.

# 2. Обработка данных

- 8. Построим ВАХ разряда (рис. 2). Проведем прямую через точки, лежащие в правой нижней области и найдем маскмальное дифференциальное сопротивление разряда  $R_{\text{диф}} = \frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}I} = -3.1 \pm 0.2$  Ом. Полученная зависимость вероятнее всего является частью участка Г-Д ВАХ разряда, представленной в лабнике.
- 9. Теперь построим зондовые характеристики для разных токов (рис. 3). Проведем касательную в нуле и асимптоты в бесконечностях чтобы определить производную  $\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}|_{U=0}$  и ток насыщения  $I_{i\mathrm{H}}$ . После этого найдем температуру электронов в Кельвинах по формуле:

$$kT_e = \frac{1}{2} \frac{eI_{i\mathrm{H}}}{\left.\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}\right|_{U=0}}$$

10. Результаты вычислений с погрешностями, полученные в предыдущем пункте и во всех последующих будут представлены в сводной таблице в коцне работы.

11. Вычислим концентрацию электронов с помощью формулы Бома, полагая, что  $n_e=n_i$ :

$$n_e = \frac{5}{2} \frac{I_{i\text{H}}}{e\pi l d} \sqrt{\frac{m_i}{2kT_e}}$$

12. Рассчитаем плазменную частоту колебаний электронов по формуле:

$$\omega_p = \sqrt{rac{4\pi n_e e^2}{m_e}} = 5.6 \cdot 10^4 \sqrt{n_e} \,\, rac{\mathrm{paд}}{\mathrm{c}}$$

Рассчитаем электронную поляризационную длину  $r_{D_e}$  по формуле:

$$r_{D_e} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}}$$

Также найдем дебаевский радиус экранирования  $r_D$ , принимая температуру ионов равной комнатной ( $T_i \approx 300~{
m K}$ ):

$$r_D = \sqrt{\frac{kT_i}{4\pi n_e e^2}}$$

13. Оценим среднее число ионов в дебаевской сфере:

$$N_d = \frac{4}{3}\pi r_D^3 n_i$$

14. Оценим степень ионизации плазмы ( $P \approx 2$  торр):

$$\alpha = \frac{n_i}{n} = \frac{n_e k T_i}{P}$$

- 15. Построим графики зависимостей электронной температурыи и концентрации электронов от тока разряда:  $T_e(I_{\rm p}),\ n_e(I_{\rm p})$  (рис. 4 и рис. 5).
- 16. Ниже приведена сводная таблица полученных значений.

#### 3. Вывод

Дебаевский радиус электронов  $r_{D_e}$  много меньше поперечного размера трубки, в котором содержится плазма. Поэтому последнюю можно считать квазинейтральной. Идеальной плазму можно считать с малой точностью, так как число Дебая  $N_D$  не много больше 1.

# 4. Приложения

$I_{ m p},{ m MA}$	$kT_e$ , эВ	$n_e$ , cm <sup>-3</sup>	$\omega_p$ , рад · c <sup>-1</sup>
5	$1.056 \pm 0.013$	$(1.288 \pm 0.018) \cdot 10^{12}$	$(6.36 \pm 0.04) \cdot 10^{10}$
3	$1.969 \pm 0.004$	$(5.126 \pm 0.014) \cdot 10^{11}$	$(4.010 \pm 0.005) \cdot 10^{10}$
1.5	$2.576 \pm 0.004$	$(2.161 \pm 0.004) \cdot 10^{11}$	$(2.603 \pm 0.003) \cdot 10^{10}$
$r_{D_e}$ , cm	$r_D$ , cm	$N_D$	$\alpha$
$(6.74 \pm 0.06) \cdot 10^{-4}$	$(1.054 \pm 0.007) \cdot 10^{-4}$	$6.31 \pm 0.16$	$(2.03 \pm 0.03) \cdot 10^{-5}$
	D /	$6.31 \pm 0.16$	

Таблица 1: Сводная таблица расчетов

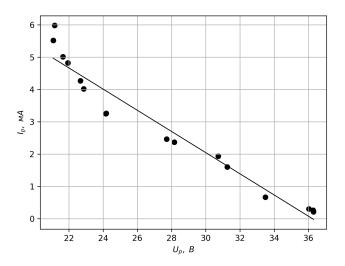


Рис. 3: Вольт-амперная характеристика разряда  $I_{\mathrm{p}}(U_{\mathrm{p}})$ 

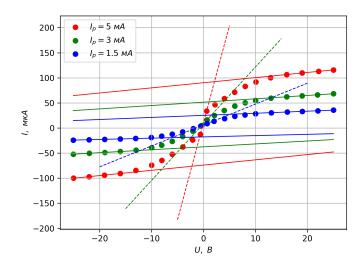


Рис. 4: Вольт-амперная характеристика зонда для разных токов разряда I(U)

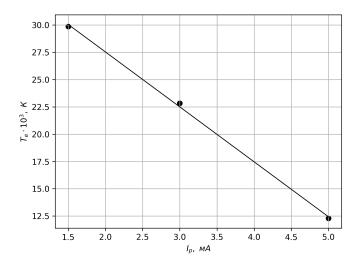


Рис. 5: Зависимость  $T_e(I_{\rm p})$ 

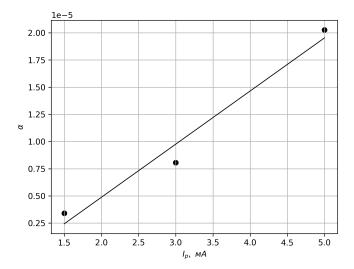


Рис. 6: Зависимость  $\alpha(I_{\mathrm{p}})$